

CORRIGENDUM 1

1 Scope

*Add at the end of clause the following
Note 3:*

NOTE 3 Type F and type B RCDs have high resistance against unwanted tripping, even if the surge voltage causes a flashover and a follow-on current occurs, and in case of inrush residual currents with a maximum duration of 10 ms which can occur in case of switching ON electronic equipment or EMC-filters.

9.2.1.2 Verification of the correct operation in case of residual sinusoidal alternating currents up to 1 000 Hz

Replace the last sentence of item a) by the following:

The test is carried out on one pole taken at random at each frequency given in Table 2 and repeated twice; the tripping values shall be in compliance with Table 2.

Replace the third sentence of item b) by the following:

Two measurements of the break time are made on one pole taken at random.

9.2.1.3 Verification of the correct operation in the case of a residual alternating current superimposed on a residual smooth direct current

Add the following note after the second sentence:

NOTE In the particular case of a $I_{\Delta n}$ 10 mA type B RCD, the value of 5 mA smooth DC is used.

1 Domaine d'application

Ajouter à la fin de l'article la Note 3 ci-dessous:

NOTE 3 Les DDR de type F et de type B disposent d'une haute résistance contre les déclenchements intempestifs, y compris lorsque l'onde de surtension provoque un amorçage et qu'un courant de suite survient, et en cas d'appel de courant résiduel d'une durée maximale de 10 ms qui peut survenir en cas de mise en marche d'un équipement électronique ou filtre CEM.

9.2.1.2 Vérification du fonctionnement correct en cas de courants différentiels alternatifs sinusoïdaux jusqu'à 1 000 Hz

Remplacer la dernière phrase du point a) par la phrase suivante:

L'essai est réalisé sur un pôle pris au hasard à chaque fréquence indiquée dans le Tableau 2 et réalisé deux fois; les valeurs de déclenchement doivent être conformes au Tableau 2.

Remplacer la troisième phrase du point b) par la phrase suivante:

Deux mesures du temps de fonctionnement sont réalisées sur un pôle pris au hasard.

9.2.1.3 Vérification du fonctionnement correct en cas de courant différentiel alternatif superposé sur un courant différentiel continu lissé

Ajouter la note suivante après la deuxième phrase:

NOTE Dans le cas particulier d'un DDR de type B de $I_{\Delta n}$ 10 mA, la valeur de 5 mA est utilisée pour le courant continu lissé.